

9月15日(火) 会場変更のお知らせ

CS2 3.11/13.7 コードシェアセッション 2C会場→1H会場

4.5 Information Photonics

2F会場→2C会場

日程表(会場別) 1

名古屋国際会議場

会場名	収容人数	9月13日(日)		9月14日(月)		9月15日(火)		9月16日(水)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
1号館	CE センチュリー ホール	3000		特別シンポジウム ノーベル賞受賞者からの未来へのメッセージ				特別シンポジウム 人工光合成: 材料・物性・デバイスとシステムからのアプローチ		特別シンポジウム「新第6次産業革命」～人と技術の融合による未来産業と社会～
	1A 131+132	162	15.2 II-VI 族結晶および多元系結晶	S.19 機能性原子薄膜化合物材料の応用展開	S.5 International Symposium on Thin Film Technologies for Flexible Devices	S.5 International Symposium on Thin Film Technologies for Flexible Devices	15.6 IV 族系化合物 (SiC)	15.6 IV 族系化合物 (SiC)	15.6 IV 族系化合物 (SiC)	
	1B 133+134	162	T4 チュートリアル: 淵 真悟	S.21 界面ナノ電子化学「進化する半導体ウェットプロセス ～シリコンから化合物まで～」	21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	S.20 酸化物半導体の評価技術	21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	
	1C 135	70	13.4 Si プロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Si プロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Si プロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.4 Si プロセス・配線・MEMS・集積化技術	13.5 デバイス/集積化技術	13.5 デバイス/集積化技術	13.5 デバイス/集積化技術	
	1D 141+142	360	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	S.3 フォトニクス分科会発定記念シンポジウム「フォトニクスの夢」	15.4 III-V 族窒化物結晶	S.17 窒化物半導体特異構造の科学～表面・界面の制御と物理～	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶
	1E 143	70		15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御	3.13 半導体光デバイス	3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器
	1F レセプション ホール1	288		8.8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 8.0 Plasma Electronics English Session	8.9 プラズマエレクトロニクス受賞記念講演 8.8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	S.9 プラズマ医療科学の最前線	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池		応用女子会
	1G レセプション ホール2	288	12.4 有機 EL・トランジスタ	S.13 有機エレクトロニクスの萌芽的研究	12.5 有機太陽電池 S.12 有機無機ヘロプカイト太陽電池の現状と今後の展望	S.12 有機無機ヘロプカイト太陽電池の現状と今後の展望	12.4 有機 EL・トランジスタ	12.4 有機 EL・トランジスタ	12.4 有機 EL・トランジスタ	12.4 有機 EL・トランジスタ
2号館	2A 211-1	100	3.2 材料・機器光学	SC 交流会	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	12.6 ナノバイオテクノロジー	12.6 ナノバイオテクノロジー	3.11 フォトニック構造・現象	3.11 フォトニック構造・現象
	2B 211-2	100	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス	12.7 医用工学・バイオチップ	12.7 医用工学・バイオチップ	13.9 光物性・発光デバイス	13.9 光物性・発光デバイス
	2C 212-1	100	4.1 Plasmonics	4.1 Plasmonics	4.1 Plasmonics	4.3 Optical Micro-sensing, Manipulation, and Fabrications		CS2 3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション	4.2 Bio- and Medical Photonics	4.2 Bio- and Medical Photonics
	2D 212-2	60	3.5 レーザー装置・材料	3.5 レーザー装置・材料	3.5 レーザー装置・材料	4.4 Opto-electronics	4.6 Nanocarbon and 2D materials photonics	4.6 Nanocarbon and 2D materials photonics	13.6 Semiconductor English Session 13.1 Si 系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13.1 Si 系基礎物性・表面界面・シミュレーション
	2E 221-1	60	3.1 光学基礎・光学新領域	3.1 光学基礎・光学新領域	3.3 情報フォトニクス・画像工学	3.3 情報フォトニクス・画像工学	4.7 Terahertz Photonics	4.7 Terahertz Photonics	3.13 半導体光デバイス	3.13 半導体光デバイス
	2F 221-2	60	3.7 レーザープロセッシング	3.7 レーザープロセッシング	3.7 レーザープロセッシング	3.7 レーザープロセッシング	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	4.5 Information Photonics	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	
	2G 2階ラウンジ 1	100	3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー	CS1 3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学
	2H 222	126	T1 チュートリアル: 川田 善正	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	S.7 機能性材料・デバイス解析の最近の動向	6.3 酸化物エレクトロニクス	
	2J 223	126	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術 10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術	6.4 薄膜新材料	S.8 機能性酸化物の原子・ナノスケール機能開拓最前線	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般
	2K 225	42	1.5 計測技術・計測標準		1.6 超音波	15.1 バルク結晶成長	1.1 応用物理一般・学際領域	1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	1.3 新技術・複合新領域	
	2L 2階ラウンジ 2	100	9.1 誘電材料・誘電体			S.1 企業・地域等が連携したサイエンスコミュニケーション	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	
	2M 224-1 南側	130	T2 チュートリアル: 安井 武史	S.22 原子・電子構造制御による次世代デバイス開発に向けた基礎研究と新展開 一多元系化合物ベースの次期太陽電池・新規熱電物質・電子相関物質一	13.10 化合物太陽電池	13.10 化合物太陽電池	13.10 化合物太陽電池	S.4 量子情報へ向けたシリコントテクノロジーからの挑戦		
	2N 224-2 北側	80			3.15 シリコンフォトニクス	3.4 生体・医用光学	CS3 6.6 フロープ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	
	2Q 231-1	60	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	8.4 プラズマエッチング	8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.5 プラズマナノテクノロジー 8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.3 プラズマ成膜・表面処理
	2R 231-2	60	9.5 新機能材料・新物性	9.5 新機能材料・新物性		16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス		13.2 探索的材料物性・基礎物性	13.2 探索的材料物性・基礎物性	
	2S 3階ラウンジ	100	3.15 シリコンフォトニクス	3.15 シリコンフォトニクス	3.9 テラヘルツ全般	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池		
	2T 232	126	9.4 熱電変換	9.4 熱電変換	17.1 成長技術	17.1 成長技術 17.2 構造制御・プロセス	17.4 デバイス応用	17.3 新機能探索・基礎物性評価		17.2 構造制御・プロセス
	2U 233	126	T3 チュートリアル: 日高 睦夫	17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.1 成長技術	17.4 デバイス応用 17.2 構造制御・プロセス		17.4 デバイス応用 17.1 成長技術	6.6 フロープ顕微鏡	6.6 フロープ顕微鏡
2V 234-1 南側	130		12.5 有機太陽電池		S.2 化学分析技術と放射線	8.2 プラズマ診断・計測	8.1 プラズマ生成・制御	8.6 プラズマライファイエンス	8.6 プラズマライファイエンス	
2W 234-2 北側	80	15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶	15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 15.7 エピタキシーの基礎	2.1 放射線物理一般・検出器基礎	2.2 検出器開発	2.3 放射線応用・発生装置・新技術	2.2 検出器開発	

9月15日(火) 会場変更のお知らせ

CS2 3.11/13.7 コードシェアセッション 2C会場→1H会場
4.5 Information Photonics 2F会場→2C会場

日程表 (会場別) 2

名古屋国際会議場

会場名	収容人数	9月13日(日)		9月14日(月)		9月15日(火)		9月16日(水)																																				
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後																																			
3号館	3A 国際会議室	336	講演奨励賞贈呈式	2015年度国際フェロー特別講演 本部行事	S.11 English session: Asian Joint Symposium on Nanobiotechnology	S.11 English session: Asian Joint Symposium on Nanobiotechnology	10.2 スピントルク・スピントロニクス・回路・測定技術	S.10 新規スピントロニクス現象と応用の可能性	10.4 半導体・有機・光子スピントロニクス	10.4 半導体・有機・光子スピントロニクス																																		
											4号館	4A 431-1	60	11.1 基礎物性	11.1 基礎物性		11.4 アナログ応用および関連技術	11.4 アナログ応用および関連技術	11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	9.3 ナノエレクトロニクス																								
																					4B 431-2	60			10.5 磁場応用	11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用																	
																													4C 432	196	13.3 絶縁膜技術	S.14 Ge-CMOS はどこまで進んでいるのか	13.3 絶縁膜技術	S.15 越境する絶縁膜/半導体界面技術 ~ Si から Non-Si へ ~	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術							
																																						4D 436	50		13.7 ナノ構造・量子現象	11.3 超伝導・超伝導パワー応用	3.10 光子量子物理・技術	
4F 438	196	12.3 機能材料・萌芽的デバイス	S.18 液体シリコンの科学と最新動向	6.2 カーボン系薄膜	S.6 誘電体・強誘電体材料およびデバイスの新展開を求めて	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜																																					
										イベントホール	PA1 ~ PA14	ホスターセッション					[13:30~15:30] 10 スピントロニクス・マグネティクス	[13:30~15:30] 9.3 ナノエレクトロニクス	[09:30~11:30] 3.10 光子量子物理・技術 17 ナノカーボン																									
[16:00~18:00] 3.2 材料・機器光学 3.3 情報フォトニクス・画像工学 12.4 有機EL・トランジスタ 13.3 絶縁膜技術 13.9 光物性・発光デバイス	[09:30~11:30] 6.1 強誘電体薄膜 9.1 誘電材料・誘電体 11 超伝導	[16:00~18:00] 3.9 テラヘルツ全般 3.13 半導体光デバイス 6.2 カーボン系薄膜 6.4 薄膜新材料 6.6 フローブ顕微鏡	[09:30~11:30] 1.2 教育 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 3.8 光計測技術・機器 3.11 フォトニック構造・現象	[16:00~18:00] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.3 新技術・複合新領域 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション																																								
					[18:30~20:30] 2 放射線	[18:30~20:30] 3.7 レーザープロセッシング 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.5 表面物理・真空	[18:30~20:30] 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学																																					
								白鳥ホール	PB1 ~ PB12											ホスターセッション			[13:30~15:30] 15.2 II-VI 族結晶および多元系結晶 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 15.7 エピタキシーの基礎	[13:30~15:30] 13.7 ナノ構造・量子現象 13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	[13:30~15:30] 13.10 化合物太陽電池																			
[16:00~18:00] S.11 English session: Asian Joint Symposium on Nanobiotechnology 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス	[09:30~11:30] 3.4 生体・医用光学 3.14 光制御デバイス・光ファイバー 4 JSAP-OSA Joint Symposia 2015 13.5 デバイス/集積化技術 15.1 ハルク結晶成長 15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶 16 非晶質・微結晶	[16:00~18:00] 1.5 計測技術・計測標準 1.6 超音波 12.2 評価・基礎物性 15.6 IV 族系化合物(SiC) 15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	[09:30~11:30] 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 12.1 作製・構造制御 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術 13.6 Semiconductor English Session	[16:00~18:00] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.3 新技術・複合新領域 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション																																								
					[18:30~20:30] 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 12.5 有機太陽電池	[18:30~20:30] 7.1 X線技術 7.2 電子ビーム応用 7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術 7.6 イオンビーム一般 15.4 III-V 族窒化物結晶	[18:30~20:30] 8 フラスマエレクトロニクス																																					